

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 3 年 9 月 30 日 (2021.9.30)

【公開番号】特開 2020-191480 (P2020-191480A)

【公開日】令和 2 年 11 月 26 日 (2020.11.26)

【年通号数】公開・登録公報 2020-048

【出願番号】特願 2020-143091 (P2020-143091)

【国際特許分類】

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/8234 (2006.01)

H 0 1 L 27/06 (2006.01)

H 0 1 L 27/088 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 29/417 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 29/78 6 1 6 U

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

H 0 1 L 29/78 6 1 6 V

H 0 1 L 27/06 1 0 2 A

H 0 1 L 27/088 C

H 0 1 L 27/088 3 3 1 E

H 0 1 L 21/28 3 0 1 B

H 0 1 L 29/50 M

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 8 月 23 日 (2021.8.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

同一基板上に画素部と駆動回路部とを有し、

前記画素部は、第 1 の酸化物半導体層にチャネル形成領域を有する第 1 のトランジスタと、前記第 1 のトランジスタと電気的に接続される発光素子と、を有し、

前記駆動回路部は、第 2 の酸化物半導体層にチャネル形成領域を有する第 2 のトランジスタを有し、

前記第 1 のトランジスタは、前記第 1 の酸化物半導体層の一方側のみに、前記第 1 の酸化物半導体層と重なる第 1 のゲート電極層を有し、

前記第 2 のトランジスタは、前記第 2 の酸化物半導体層の上下両側に、前記第 2 の酸化物半導体層と重なる第 2 のゲート電極層及び第 3 のゲート電極層を有し、

前記第 1 のトランジスタは、前記第 1 の酸化物半導体層の下方に設けられた第 1 のソース電極層及びドレイン電極層を有し、

前記第 2 のトランジスタは、前記第 2 の酸化物半導体層の下方に設けられた第 2 のソース電極層及びドレイン電極層を有し、

前記発光素子は、第 1 の電極と、前記第 1 の電極上の E L 層と、前記 E L 層上の第 2 の電極と、を有する表示装置。